



Высокая стойкость к  
электротермоциклированию  
Низкие статические и динамические потери  
Разработан для промышленного применения

## Низкочастотный Тиристор Тип Т183-1600-65

Средний прямой ток			$I_{TAV}$	1600 А			
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии			$U_{DRM}$	5400 ÷ 6500 В			
Повторяющееся импульсное обратное напряжение			$U_{RRM}$				
Время выключения			$t_q$	800 мкс			
$U_{DRM}$ , $U_{RRM}$ , В	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6500
Класс по напряжению	54	56	58	60	62	64	65
$T_j$ , °C	-60 ÷ 125						

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения		
<b>Параметры в проводящем состоянии</b>						
$I_{TAV}$	Средний ток в открытом состоянии	A	1600 2235 2709	$T_c=101$ °C; двухстороннее охлаждение; $T_c=85$ °C; двухстороннее охлаждение; $T_c=70$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц		
$I_{TRMS}$	Действующий ток в открытом состоянии	A	2512	$T_c=101$ °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц		
$I_{TSM}$	Ударный ток в открытом состоянии	kA	40.0 46.0  42.0 48.0	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C  $T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ( $t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=2$ А; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ А/мкс  180 эл. град. синус; 60 Гц ( $t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=2$ А; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ А/мкс	
$I^2t$	Защитный фактор	$A^2 \cdot 10^3$	8000 10580  7320 9560	$T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C  $T_j=T_{j\max}$ $T_j=25$ °C	180 эл. град. синус; 50 Гц ( $t_p=10$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=2$ А; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ А/мкс  180 эл. град. синус; 60 Гц ( $t_p=8.3$ мс); единичный импульс; $U_D=U_R=0$ В; Импульс управления: $I_G=2$ А; $t_{GP}=50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ А/мкс	

<b>Блокирующие параметры</b>				
$U_{DRM}, U_{RRM}$	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	B	5400÷6500	$T_j \min < T_j < T_j \max;$ 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
$U_{DSM}, U_{RSM}$	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	B	5500÷6600	$T_j \min < T_j < T_j \max;$ 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс; управление разомкнуто
$U_D, U_R$	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	B	$0.75 \cdot U_{DRM}$ $0.75 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_j \max;$ управление разомкнуто
<b>Параметры управления</b>				
$I_{FGM}$	Максимальный прямой ток управления	A	10	$T_j = T_j \max$
$U_{RGM}$	Максимальное обратное напряжение управления	B	5	
$P_G$	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	5	$T_j = T_j \max$ для постоянного тока управления
<b>Параметры переключения</b>				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ( $f=1$ Hz)	A/мкс	630	$T_j = T_j \max; U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}; I_{TM} = 2 I_{TAV};$ Импульс управления: $I_G = 2$ A; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ A/мкс
<b>Тепловые параметры</b>				
$T_{stg}$	Температура хранения	°C	-60÷125	
$T_j$	Температура р-п перехода	°C	-60÷125	
<b>Механические параметры</b>				
F	Монтажное усилие	кН	60.0 ÷ 70.0	
a	Ускорение	м/с <sup>2</sup>	50 100	В не зажатом состоянии В зажатом состоянии

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения
<b>Характеристики в проводящем состоянии</b>				
$U_{TM}$	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	B	2.70	$T_j = 25$ °C; $I_{TM} = 6300$ A
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	B	1.00	$T_j = T_j \max;$ $0.5 \pi I_{TAV} < I_T < 1.5 \pi I_{TAV}$
$r_T$	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	мОм	0.320	
$I_L$	Ток включения, макс	mA	1500	$T_j = 25$ °C; $U_D = 12$ B; Импульс управления: $I_G = 2$ A; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt \geq 1$ A/мкс
$I_H$	Ток удержания, макс	mA	300	$T_j = 25$ °C; $U_D = 12$ B; управление разомкнуто
<b>Блокирующие характеристики</b>				
$I_{DRM}, I_{RRM}$	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	mA	200	$T_j = T_j \max;$ $U_D = U_{DRM}; U_R = U_{RRM}$
$(dv_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, мин	B/мкс	1000	$T_j = T_j \max;$ $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$ ; управление разомкнуто

## Характеристики управления

$U_{GT}$	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	В	5.00 3.00 2.00	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25^\circ C$ $T_j = T_{j \max}$	$U_D = 12 V; I_D = 3 A;$ Постоянный ток управления
$I_{GT}$	Отпирающий постоянный ток управления, макс	мА	500 300 200	$T_j = T_{j \min}$ $T_j = 25^\circ C$ $T_j = T_{j \max}$	
$U_{GD}$	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	В	0.35	$T_j = T_{j \max}$	$U_D = 0.67 \cdot U_{DRM};$ Постоянный ток управления
$I_{GD}$	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	мА	15.00		

## Динамические характеристики

$t_{gd}$	Время задержки включения	мкс	4.00	$T_j = 25^\circ C; V_D = 0.4 \cdot U_{DRM}; I_{TM} = 2000 A;$ Импульс управления: $I_G = 2 A$ ; $t_{GP} = 50 \text{ мкс}; di_G/dt \geq 1 A/\text{мкс}$
$t_q$	Время выключения, макс	мкс	800	$dv_D/dt = 50 \text{ В/мкс}; T_j = T_{j \max}; I_{TM} = 2000 A;$ $di_R/dt = -10 \text{ A/мкс}; V_R = 100 \text{ В};$ $V_D = 0.67 \cdot V_{DRM}$
$Q_{rr}$	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	7600	$T_j = T_{j \max}; I_{TM} = 2000 A;$ $di_R/dt = -5 \text{ A/мкс};$ $V_R = 100 \text{ В}$
$t_{rr}$	Время обратного восстановления, макс	мкс	80	
$I_{rrM}$	Ток обратного восстановления, макс	А	190	

## Тепловые характеристики

$R_{thjc}$	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс	$^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	0.0065	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
$R_{thjc-A}$			0.0143		Охлаждение со стороны анода
$R_{thjc-K}$			0.0117		Охлаждение со стороны катода
$R_{thck}$	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс	$^{\circ}\text{C}/\text{Вт}$	0.0015	Постоянный ток	

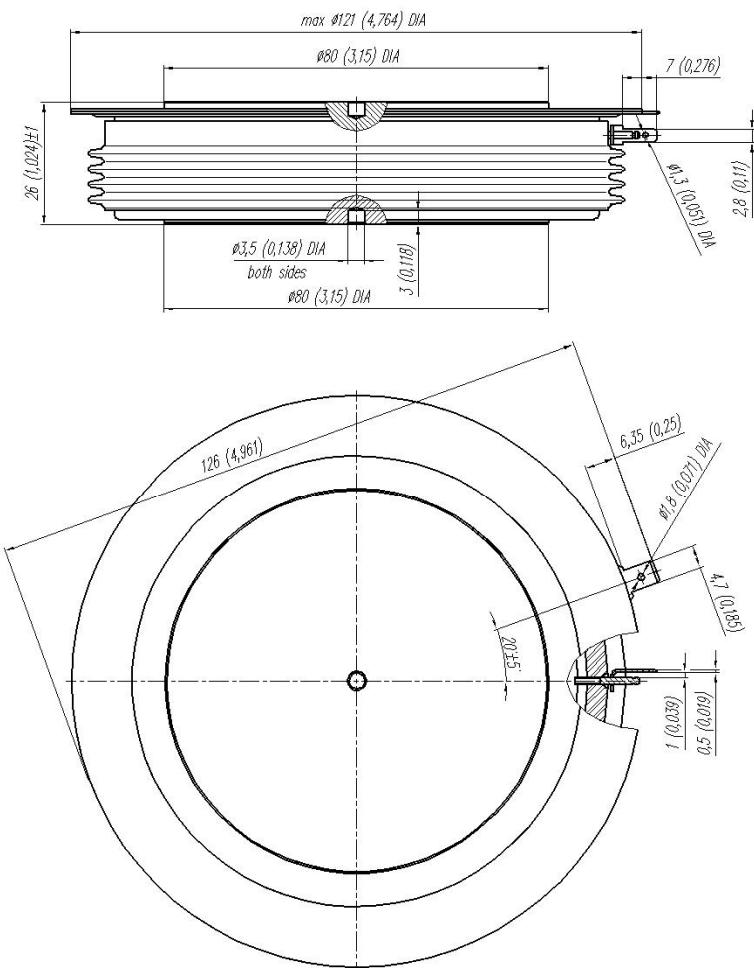
## Механические характеристики

$w$	Масса, тип	$\Gamma$	1900	
$D_s$	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	36.50 (1.437)	
$D_a$	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	16.5 (0.650)	

## МАРКИРОВКА

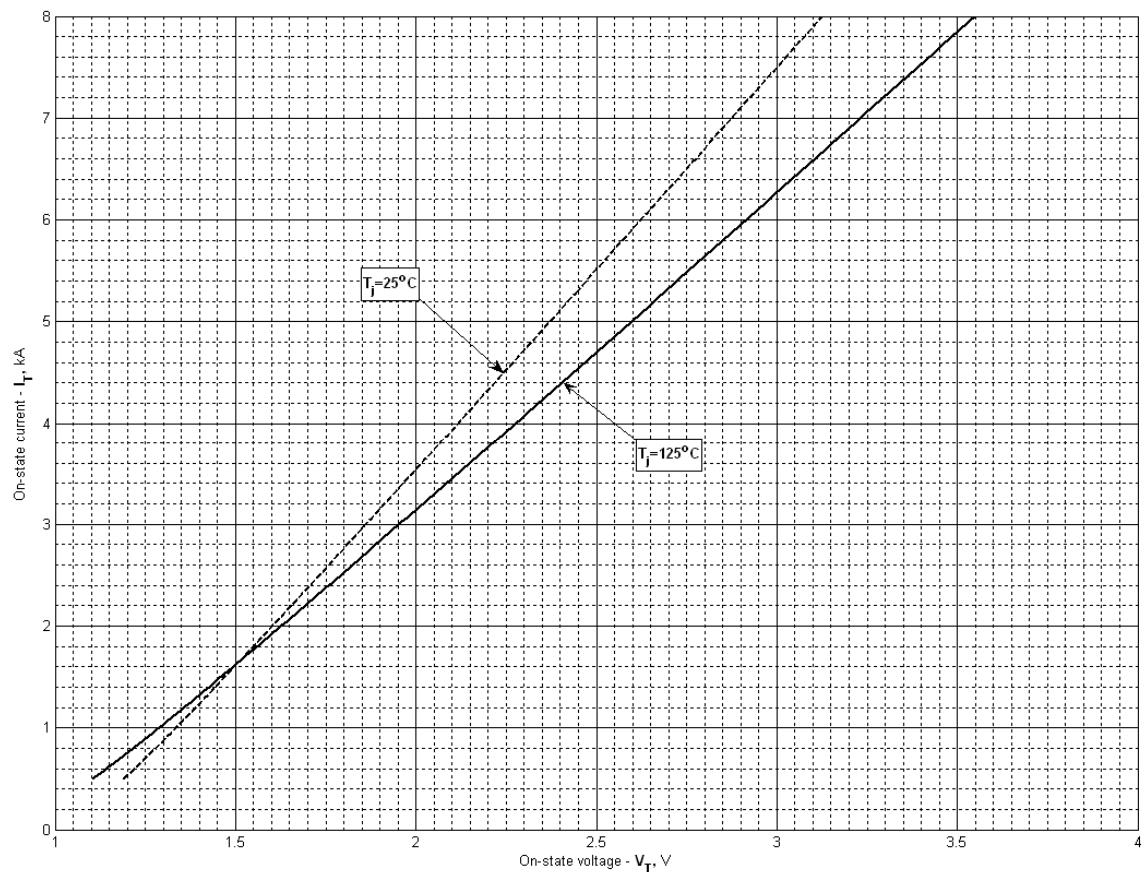
T	183	1600	65	УХЛ2
1	2	3	4	5

- Низкочастотный тиристор
- Конструктивное исполнение
- Средний ток в открытом состоянии, А
- Класс по напряжению
- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т



Все размеры в миллиметрах (дюймах)

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав.  
В интересах улучшения качества продукции, ЗАО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без  
уведомления.



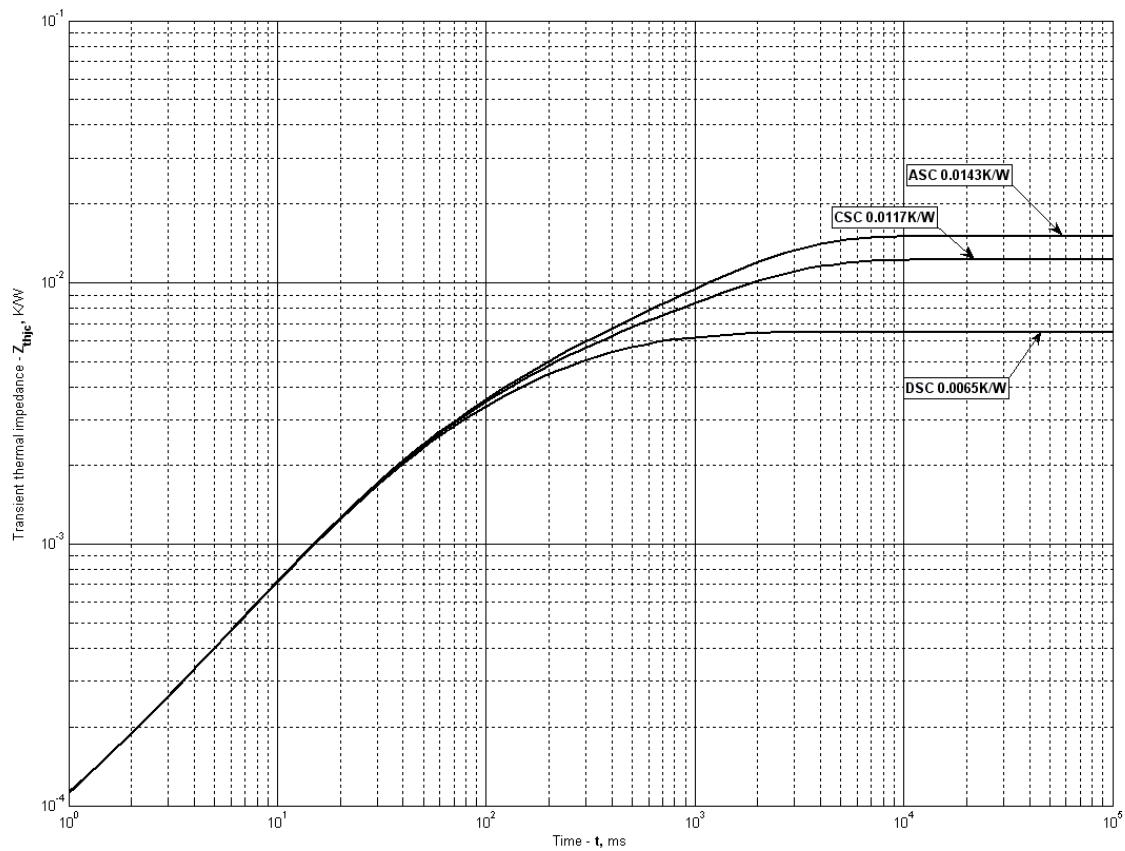
**Fig 1 – On-state characteristics of Limit device**

Analytical function for On-state characteristic:

$$V_T = A + B \cdot i_T + C \cdot \ln(i_T + 1) + D \cdot \sqrt{i_T}$$

	Coefficients for max curves	
	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$T_j = T_{j \max}$
<b>A</b>	0.913434	0.744654
<b>B</b>	0.208728	0.259885
<b>C</b>	-0.253813	-0.338985
<b>D</b>	0.388412	0.518752

**On-state characteristic model (see Fig. 1)**



**Fig 2 – Transient thermal impedance**

Analytical function for Transient thermal impedance junction to case  $Z_{thjc}$  for DC:

$$Z_{thjc} = \sum_{i=1}^n R_i \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_i}} \right)$$

Where  $i = 1$  to  $n$ ,  $n$  is the number of terms in the series.

$t$  = Duration of heating pulse in seconds.

$Z_{thjc}$  = Thermal resistance at time  $t$ .

$R_i$  = Amplitude of  $p_{th}$  term.

$\tau_i$  = Time constant of  $r_{th}$  term.

DC Double side cooled

i	1	2	3	4	5	6
$R_i$ , K/W	0.001031	0.003117	0.001895	0.0004176	2.061e-005	1.999e-005
$\tau_i$ , s	0.7345	0.209	0.05291	0.01652	0.0006764	0.0002168

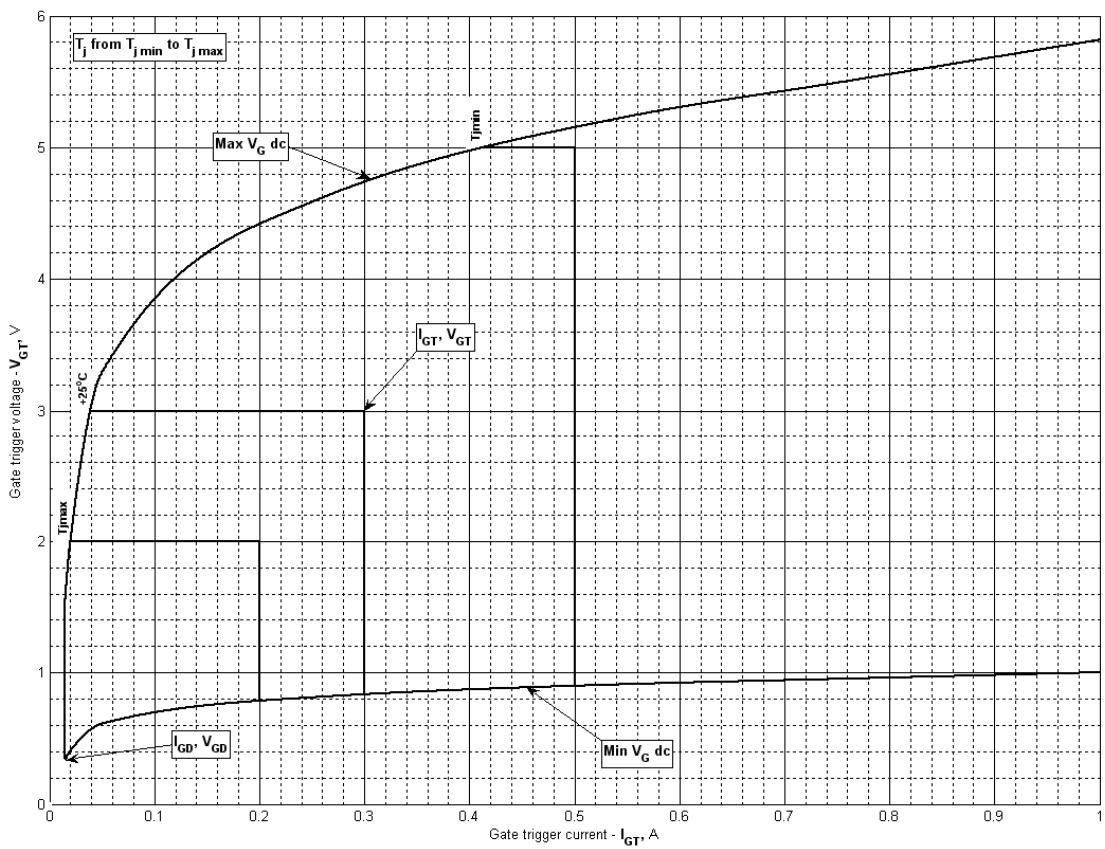
DC Cathode side cooled

i	1	2	3	4	5	6
$R_i$ , K/W	0.001475	0.005797	0.002722	0.001822	0.0003923	3.824e-005
$\tau_i$ , s	0.8755	1.835	0.1997	0.05221	0.01594	0.0003499

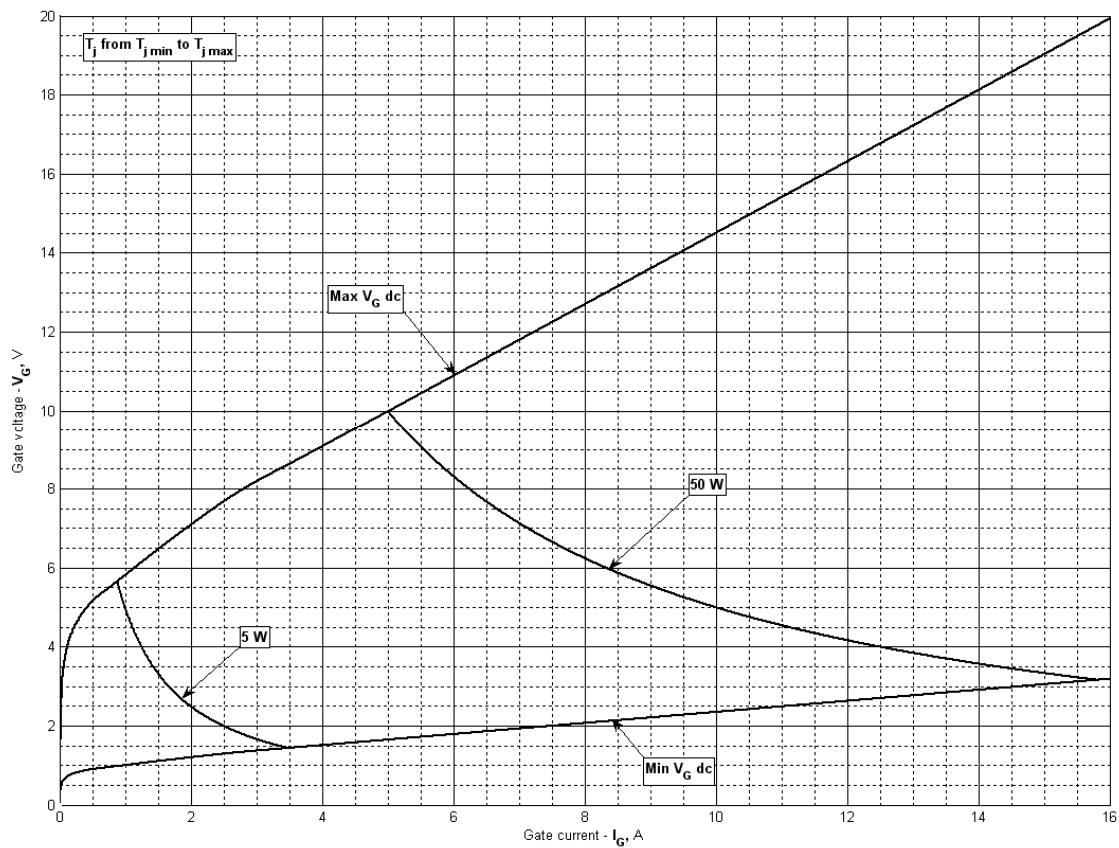
DC Anode side cooled

i	1	2	3	4	5	6
$R_i$ , K/W	0.00848	0.001792	0.002597	0.00179	0.0003904	3.851e-005
$\tau_i$ , s	1.845	0.9581	0.2011	0.05234	0.01605	0.0003606

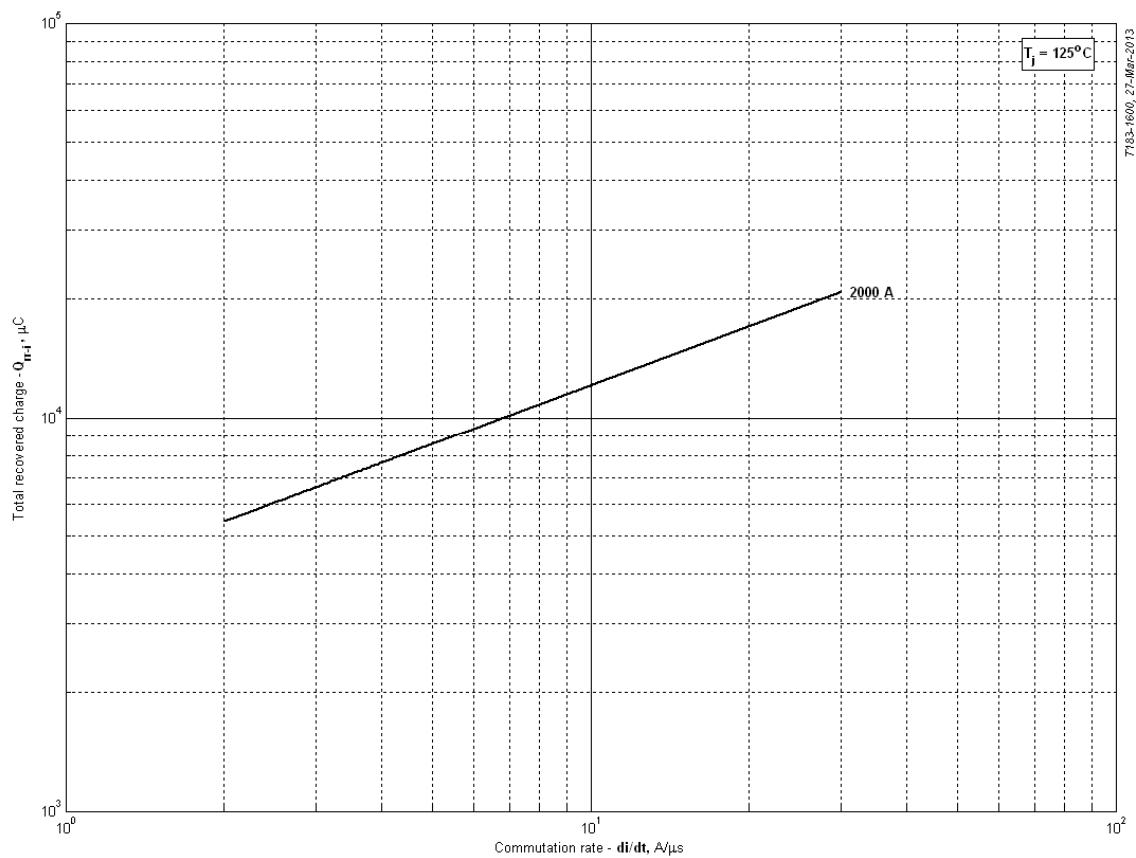
**Transient thermal impedance junction to case  $Z_{thjc}$  model (see Fig. 2)**



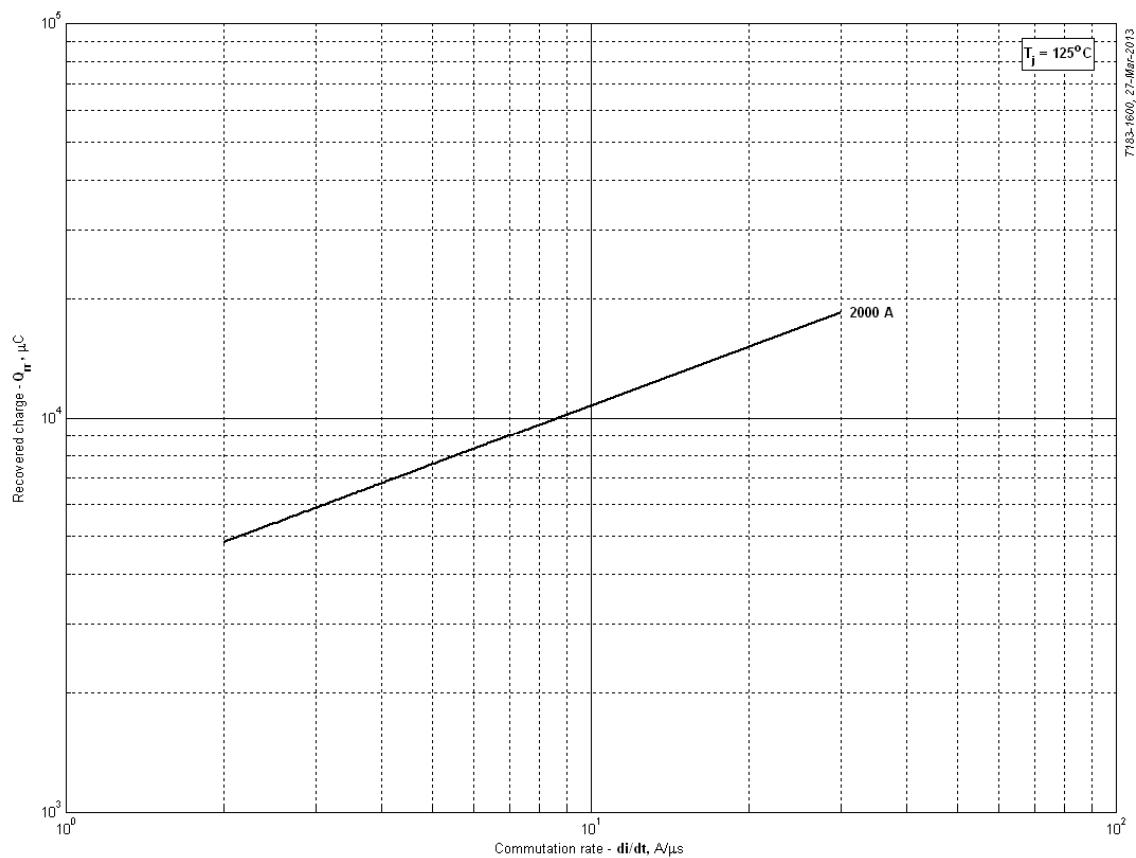
**Fig 3 – Gate characteristics – Trigger limits**



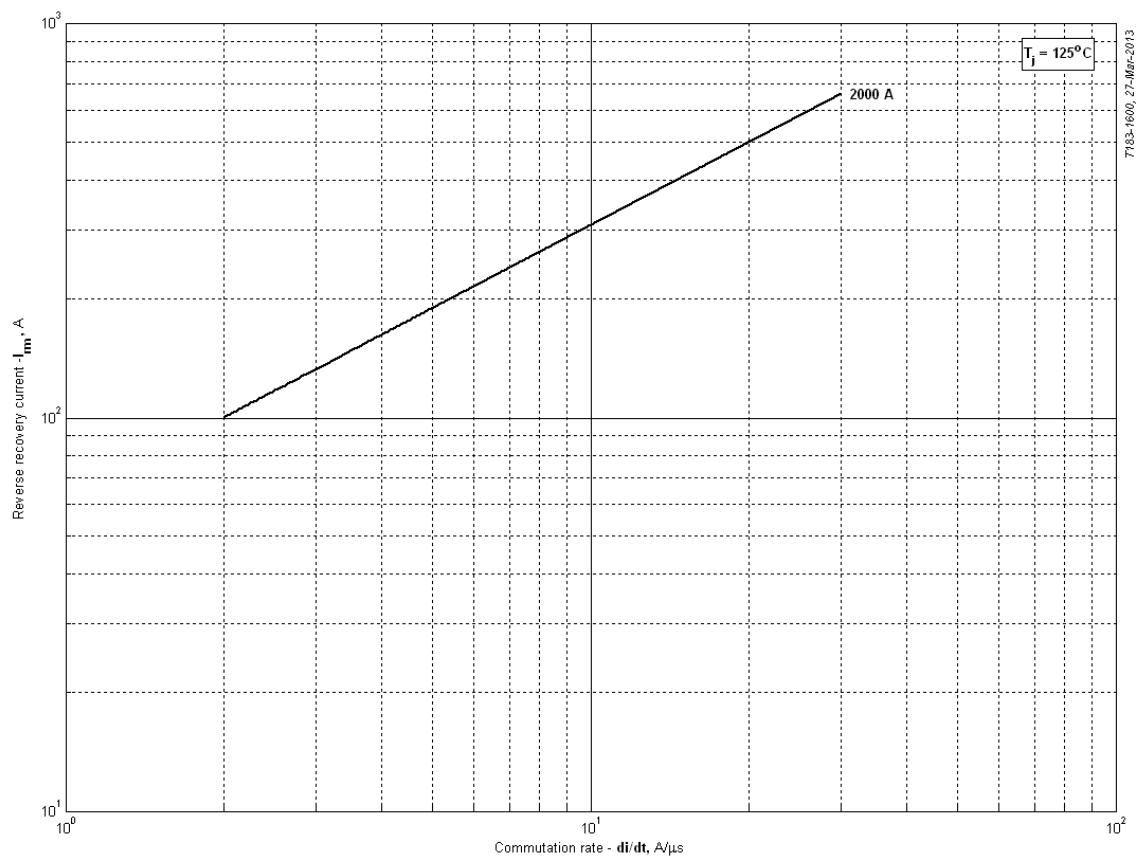
**Fig 4 - Gate characteristics –Power curves**



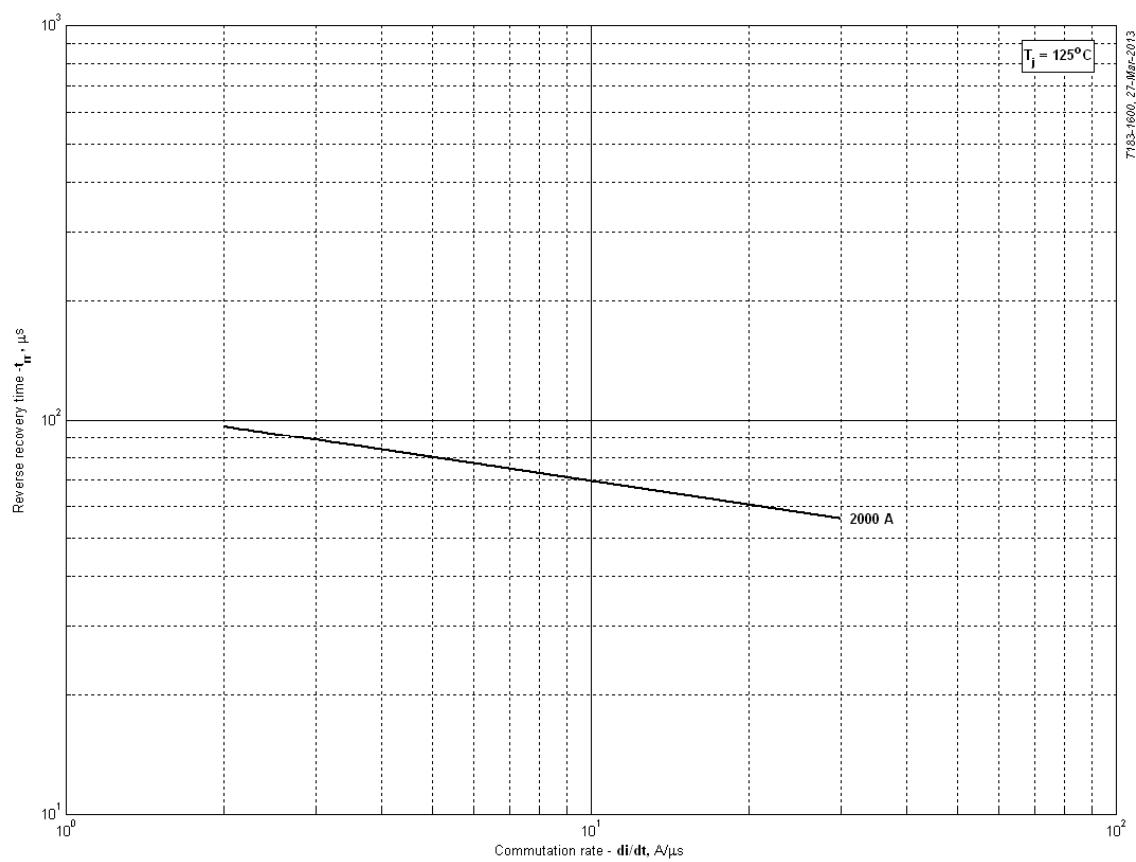
**Fig 5 – Total recovered charge,  $Q_{rr-i}$  (integral)**



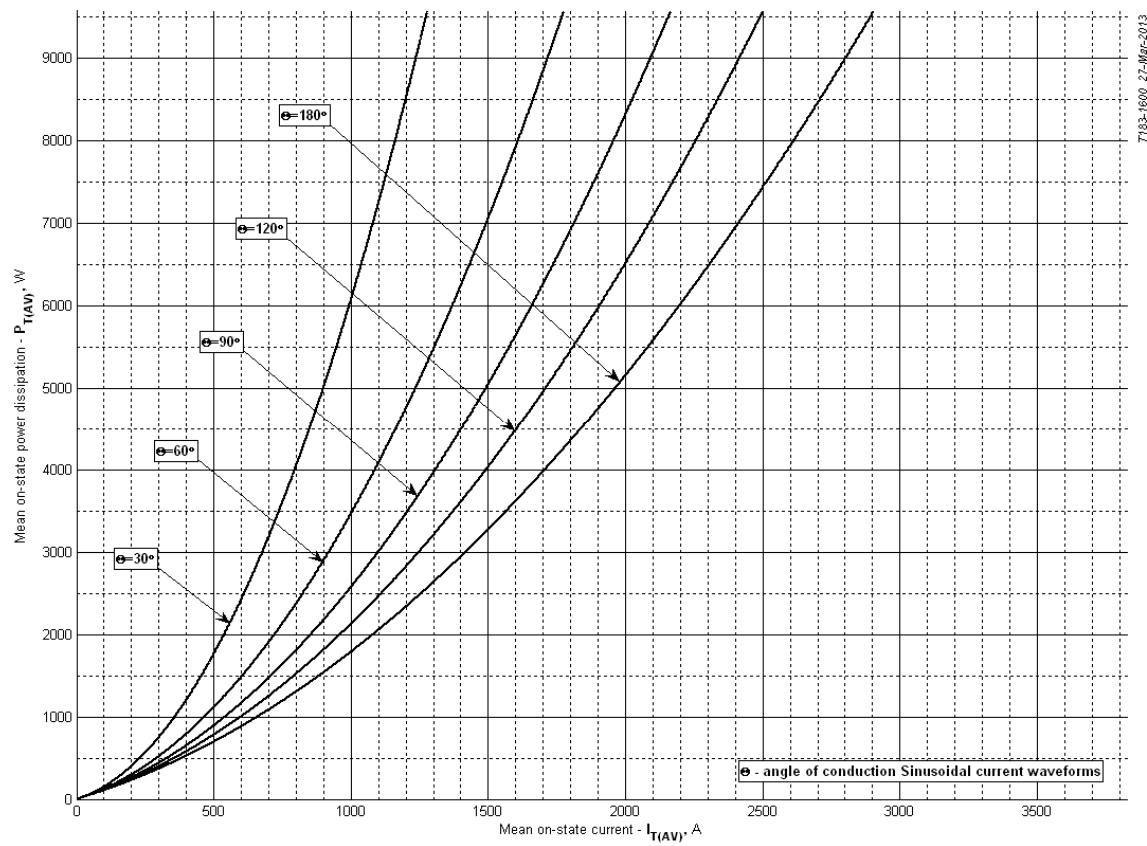
**Fig 6 - Recovered charge,  $Q_{rr}$  (linear)**



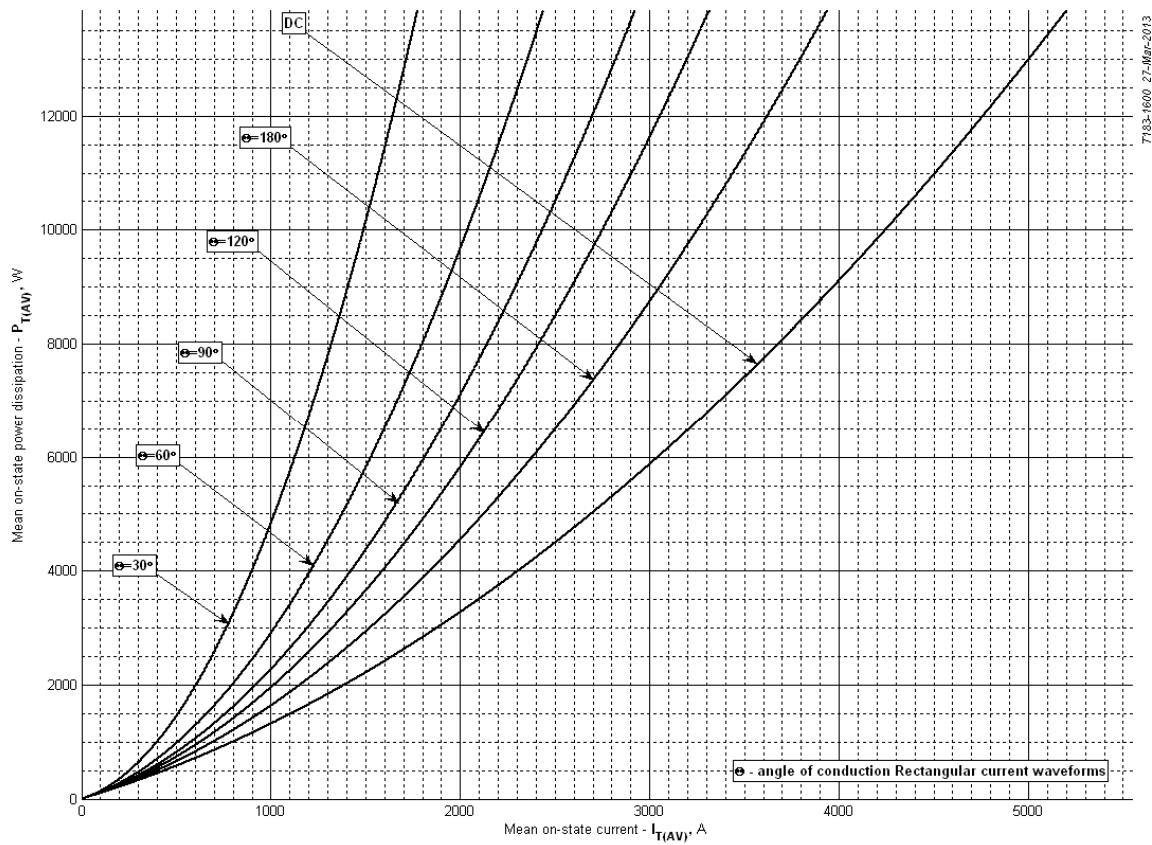
**Fig 7 – Peak reverse recovery current,  $I_{rm}$**



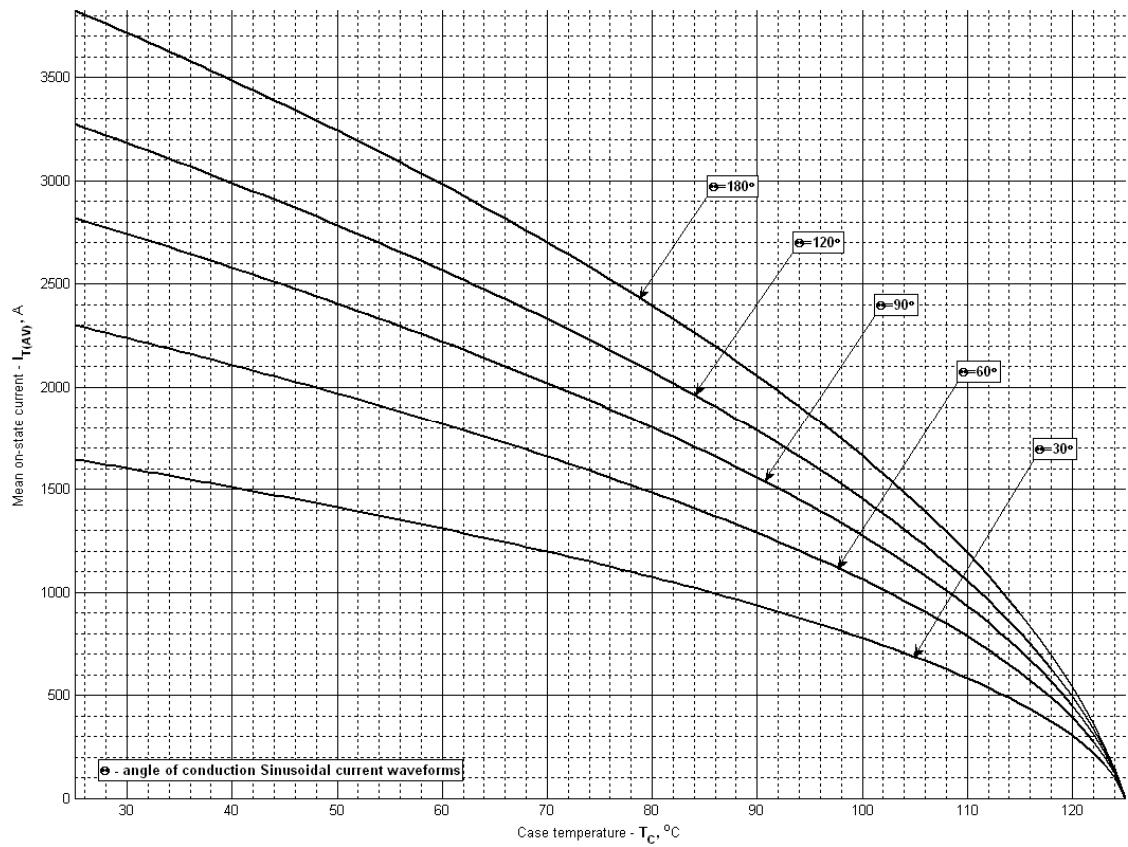
**Fig 8 – Maximum recovery time,  $t_{rr}$  (linear)**



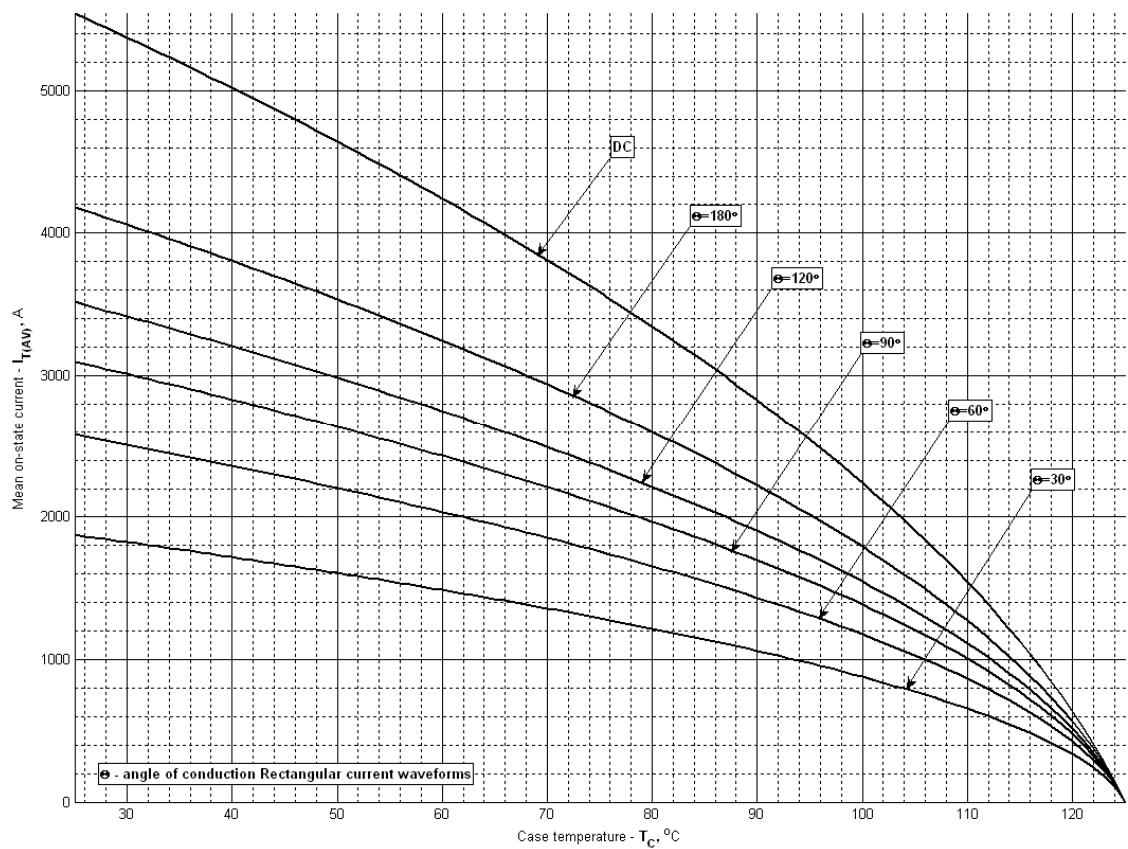
**Fig 9 – On-state power loss (sinusoidal current waveforms)**



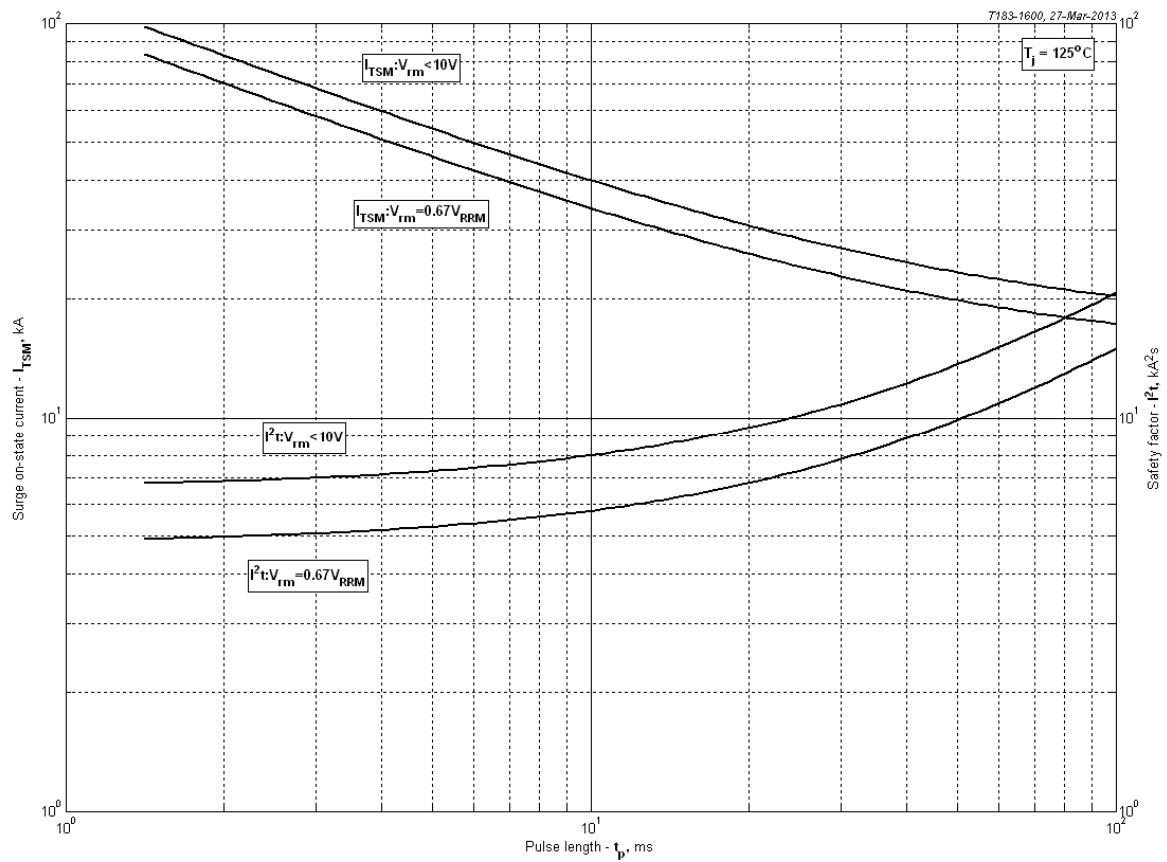
**Fig 10 – On-state power loss (rectangular current waveforms)**



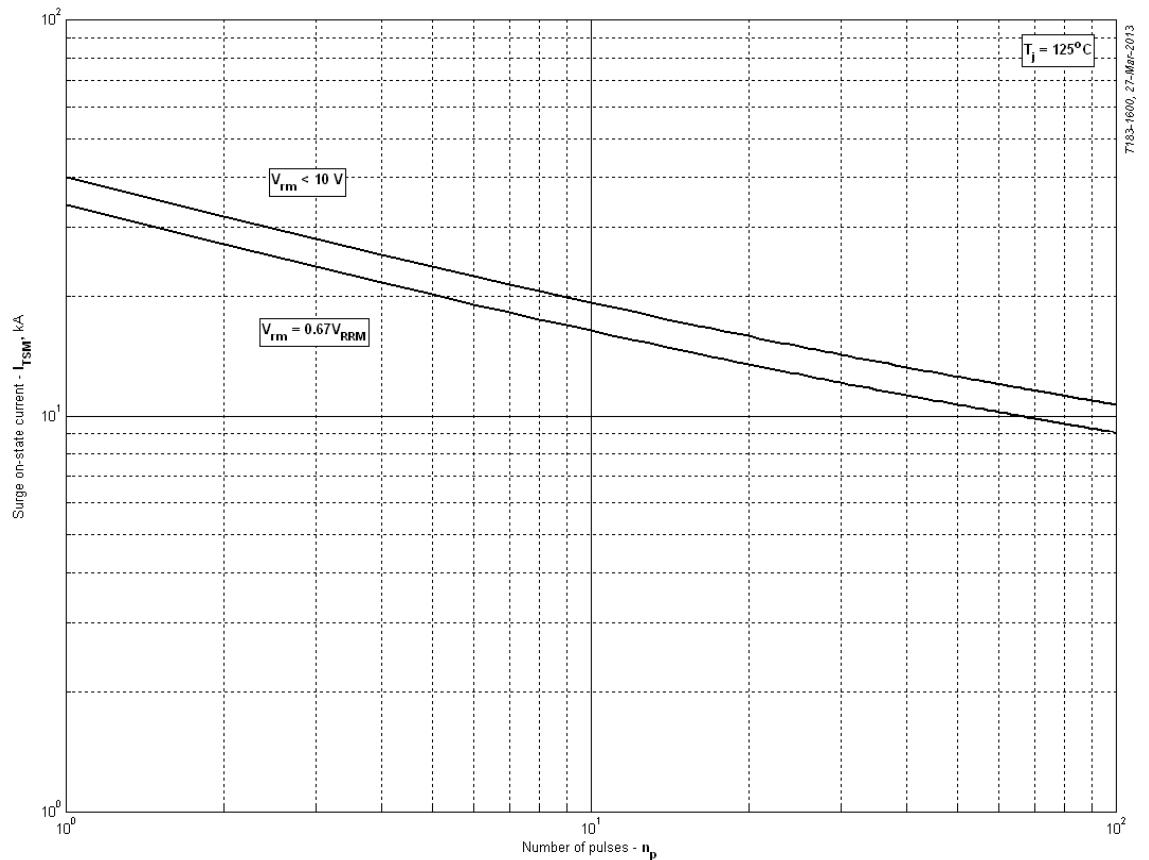
**Fig 11 – Maximum case temperature DSC (sinusoidal current waveforms)**



**Fig 12 – Maximum case temperature DSC (rectangular current waveforms)**



**Fig 13 – Maximum surge and  $I^2t$  ratings**



**Fig 14 – Maximum surge ratings**